

Сведения и публикации официального оппонента


по диссертационной работе Темнова Александра Михайловича
«ГИБРИДНО-МОНОЛИТНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СВЧ»

на соискание ученой степени доктора технических наук
 по специальности 05.27.01 «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты,
 микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах»

ФИО, ученая степень, должность	Гамкредидзе Сергей Анатольевич, доктор технических наук, профессор
Наименование отрасли науки, научной специальности, по которой защищена диссертация	05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
Полное наименование организации	Федеральное государственное автономное научное учреждение Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В. Г. Мокерова Российской академии наук
Краткое наименование организации	ФГАНУ ИСВЧПЭ РАН; ИСВЧПЭ РАН
Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Почтовый индекс, адрес	117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 7, стр. 5
Веб-сайт	http://www.new.isvch.ru
Телефон	8 (495) 280-75-48
Адрес электронной почты	gamkrelidze@isvch.ru

№ п.п.	Публикации
1.	Гамкредидзе С.А. Каскодная монолитная интегральная схема малошумящего усилителя в диапазоне частот 8-12 ГГц на наногетероструктуре нитрида галлия / С.А. Гамкредидзе, П.П. Мальцев, Ю.В. Федоров, Д.Л. Гнатюк, А.В. Зуев, М.В. Майтама, А.О. Михалев // Нано- и микросистемная техника. 2020. Т. 22. № 2. С. 98-102.
2.	Гамкредидзе С.А. Микропотребляющие усилители мощности на нитриде галлия для диапазона частот 8–12 ГГц / С.А. Гамкредидзе, Д.Л. Гнатюк, А.В. Зуев, М.В. Майтама, П.П. Мальцев, А.О. Михалев, Ю.В. Федоров // Микроэлектроника. 2019. Т. 48. № 4. С. 308-314.
3.	Редькин С.В. Лазерное плазмохимическое фрагментирование пластин Al ₂ O ₃ (сапфир) и GaAs на кристаллы / С.В. Редькин, А.С. Скрипниченко, П.П. Мальцев, С.А. Гамкредидзе // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. 2018. Т. 18. № 2. С. 478-481.
4.	Павлов А.Ю. Технология изготовления взаимодополняющих транзисторов на нитриде галлия / А.Ю. Павлов, С.А. Гамкредидзе, К.Н. Томош, Ю.В. Федоров, В.Ю. Павлов, Р.Р. Галиев, П.П. Мальцев // Проблемы разработки перспективных микро- и нанoeлектронных систем (МЭС). 2018. № 3. С. 69-74.
5.	Гамкредидзе С.А., Ильяков В.А., Лисицкий А.П., Савельев Ю.Н. Монолитная интегральная схема малошумящего усилителя X-диапазона на гетероструктуре AlGaN/AlN/GaN на подложке SiC // Успехи прикладной физики. 2018. Т. 6. № 6. С. 542-546.

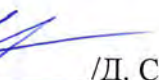
6.	Гамкрелидзе С.А. Влияние резки диском с алмазной режущей кромкой приборных пластин карбида кремния на технико-эксплуатационные параметры монолитных схем / С.А. Гамкрелидзе, А.А. Трофимов, Н.В. Щаврук // Микроэлектроника. 2017. Т. 46. № 5. С. 348-354.
7.	Гамкрелидзе С.А. Монолитные СВЧ ИС миллиметрового диапазона на основе нитридных гетероструктур с интегрированными антенными элементами / С.А. Гамкрелидзе, П.П. Мальцев, Ю.В. Федоров // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2017. Т. 22. № 6. С. 582-588.
8.	Гамкрелидзе С.А., Кондратенко В.С., Стыран В.В., Трофимов А.А., Щаврук Н.В. Влияние разработанных базовых методов резки приборных пластин сапфира и карбида кремния на выход годных нитридных СВЧ монолитных интегральных схем // Успехи прикладной физики. 2017. Т. 5. № 1. С. 79-85.
9.	Гамкрелидзе С.А., Трофимов А.А., Щаврук Н.В. Влияние резки диском с алмазной режущей кромкой приборных пластин карбида кремния на технико-эксплуатационные параметры монолитных схем // Микроэлектроника, том 46, № 5, стр. 348-354 (2017).
10.	Федоров Ю.В., Бугаев А.С., Павлов А.Ю., Гнатюк Д.Л., Матвеев О.С., Павлов В.Ю., Слаповский Д.Н., Томош К.Н., Енюшкина Е.Н., Галиев Р.Р., Майтама М.В., Зуев А.В., Крапухин Д.В., Гамкрелидзе С.А. Технология изготовления и разработка монолитных интегральных схем на основе нитрида галлия. // Нано- и микросистемная техника. 2017. Т. 19. № 5. С. 273-293.
11.	Арутюнян С.С., Кагирина К.А., Лаврухин Д.В., Гамкрелидзе С.А., Иванова Н.Е. Устойчивость нитридных СВЧ монолитных интегральных схем преобразователя сигнала к облучению потоком нейтронов и гамма-излучению // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2016. Т. 21. № 5. С. 435-441.
12.	Kagirina K.A., Fedorov Y.V., Lavrukhin D.V., Gamkrelidze S.A., Gnatyuk D.L., Zuev A.V., Ruban O.A., Gromov D.V. Stability analysis of monolithic integrated circuit of microwave signal converter to the influence of special factors // Russian microelectronics. 2017. V. 46. № 3. P. 149-154.
13.	Gamkrelidze S.A. Effect of diamond dicing of sic device wafers on the technical and operational parameters of monolithic integrated circuits / S.A. Gamkrelidze, A.A. Trofimov, N.V. Shchavruk // Russian Microelectronics. 2017. T. 46. № 5. С. 323-328.

 /С. А. Гамкрелидзе/

Подпись Гамкрелидзе С. А. заверяю.

Заместитель директора ИСВЧПЭ РАН
по научной работе, к.ф.-м.н., доцент



 /Д. С. Пономарёв/

« » 2020 года